

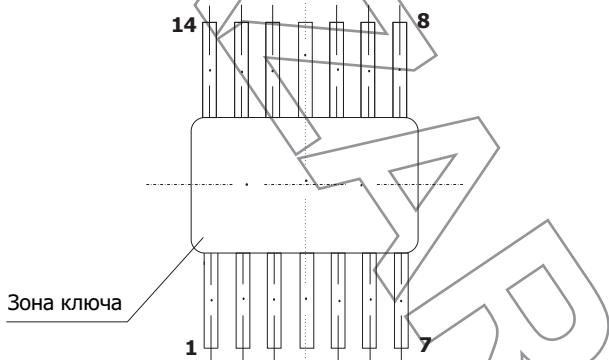
ДП КВАЗАР-ІС

ЕТИКЕТКА

Транзисторні матриці:
1НТ251,
1НТ251А.

Транзисторні матриці 1НТ251, 1НТ251А, складаються з чотирьох кремнієвих епітаксійно-планарних структур n-p-n перемикальних транзисторів та застосовуються для роботи в пристроях електронної апаратури загального призначення, які працюють у нормальних та ускладнених кліматичних умовах.

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ВИВОДІВ



Перший вивід позначений кружечком
Корпус типу 401.14-6, маса не більше 0,4 г.

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИВОДІВ

Номер виводу	Назва виводу	Номер виводу	Назва виводу
1	-	8	-
2	База Т1	9	База Т4
3	Емітер Т2	10	Емітер Т3
4	Колектор Т2	11	Колектор Т3
5	База Т3	12	База Т2
6	Емітер Т4	13	Емітер Т1
7	Колектор Т4	14	Колектор Т1

ОСНОВНІ ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ (25 ± 10) °С

Назва параметру, одиниця вимірювання (режим вимірювання)	Символ	Норма			
		1НТ251		1НТ251А	
		не менше	не більше	не менше	не більше
Статичний коефіцієнт передачі струму в схемі з спільним емітером ($U_{кб} = 5 \text{ В}$, $I_e = 200 \text{ мА}$, $f = 50 \text{ Гц}$)	h_{21E}	30	150	30	150
Зворотний струм колектора, мкА ($U_{кб} = 45 \text{ В}$)	$I_{кб0}$	-	6	-	6
Зворотний струм емітера, мкА ($U_{еб} = 4 \text{ В}$)	$I_{еб0}$	-	10	-	10
Час розсмоктування, нс ($I_k = 150 \text{ мА}$, $I_б = 15 \text{ мА}$)	t_p	-	100	-	200
Напруга насичення колектор-емітер, В ($I_k = 400 \text{ мА}$, $I_б = 80 \text{ мА}$)	$U_{кЕнас}$	-	1	-	1
Напруга насичення база-емітер, В ($I_k = 400 \text{ мА}$, $I_б = 80 \text{ мА}$)	$U_{бЕнас}$	-	1,5	-	1,5
Модуль коефіцієнту передачі струму на високій частоті ($U_{ке} = 10 \text{ В}$, $I_k = 30 \text{ мА}$, $f = 10^8 \text{ Гц}$)	$ h_{21E} $	2	-	2	-
Ємність колекторного переходу, пФ ($U_{кб} = 10 \text{ В}$, $f = 5 \times 10^6 \text{ Гц}$)	C_k	-	15	-	15
Ємність емітерного переходу, пФ ($f = 5 \times 10^6 \text{ Гц}$)	C_e	-	50	-	50

Транзисторні матриці 1НТ251, 1НТ251А відповідають технічним умовам И93.456.000 ТУ/0.